

QISA MƏLUMAT FORMASI

Adilə Ziyat qızı Abasova

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,
BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının professoru,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının Sosial
qanunvericilik şöbəsinin müdiri
İş telefonu : + (994) 12 539 05 15
e-mail: adilaabasova@yahoo.com



QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1942-ci il avqust ayının 3-də Zəngilan rayonunda anadan olub
1959-cu ildə 7 sayılı Bakı şəhər orta məktəbini medalla bitirib
Evlidir. Bir oğlu var

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsillidir. 1964-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini əla qiymətlərlə bitirib.
1970-ci ildə “ GaSe monokristallarında rekombinasiya və yapışma proseslərinin tədqiqi”
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək 01.04.10- Yarımkeçiricilər və
dielektiriklər fizikası ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi adını alıb.

1974-cü ildə baş elmi işçi diplomunu alıb.

1987-ci ildə “ $A^{III}B^{VI}$ və $A^{III}B^{III}C^{VI}_2$ - tipli laylı yarımkeçiricilərin monokristallarında və onlar
əsasında hazırlanmış işığa həssas quruluşlarda radiasiya effektləri” mövzusunda doktorluq
dissertasiyası müdafiə edərək 01.04.10- Yarımkeçiricilər və dielektiriklər fizikası ixtisası üzrə
fizika-riyaziyyat elmləri doktoru adını alıb.

1995-ci ildən professordur.

2004-cü ildən Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının Azərbaycan Bölməsinin həqiqi üzvüdür.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1964-1966 Azərbaycan EA-nın Fizika İnstitutu, baş laborant , mühəndis.

1966-1969 Azərbaycan EA-nın Fizika İnstitutunun aspirantı.

1970-1972 Azərbaycan EA-nın Fizika İnstitutu, kiçik elmi işçi.

1972-1974 Azərbaycan EA-nın Fizika İnstitutu, baş elmi işçi.

1974-1983 Moskva şəhərinə Tətbiqi Fizika Elmi Tədqiqat İnstitutuna ezam olunub.

1983-1987 Tətbiqi Fizika Elmi Tədqiqat İnstitutunun (Moskva ş.) baş elmi işçisi.

1987-1992 Tətbiqi Fizika Elmi Tədqiqat İnstitutunun (Moskva ş.) laboratoriya müdiri.

1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinə sektor müdiri vəzifəsinə dəvət olunub.

1993-1995 Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Daimi komissiyalar şöbəsinin
müdiri.

1995-ci ildən indiyədək Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sosial Qanunvericilik
şöbəsinin müdiri.

2004 2-ci dərəcə Dövlət Müşaviri ixtisas dərəcəsi alıb.

1992-ci ildən indiyədək BDU-nin Yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının professorudur.

Mükafatları:

2007-ci ildə “ Dövlət Qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif olunub.

1999-cu ildə İngiltərə Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzi tərəfindən “İlin qadını” adını alıb, həmin Mərkəz tərəfindən çap olunan “XX əsrin görkəmli şəxsləri” ensiklopedik kitabına daxil edilib və “XX əsrin görkəmli şəxsləri” diplomunu və gümüş medalını alıb.

Apardığı dərslər: Yarımkeçiricilər fizikası, fotoelektronika, yarımkeçiricilərin və yarımkeçirici cihazların parametrlərinin təyini.

130 qədər elmi məqalənin müəllifidir.

Yetişdirdiyi elmlər namizədlərinin sayı – 3.

Yetişdirdiyi elmlər doktorlarının sayı – 1.

Elmi yenilikləri: $A^{III}B^{VI}$ və $A^{III}B^{III}C^{VI}_2$ tipli layvari kristallarda yeni texnologiyanın tətbiqi ilə onlar əsasında fəthəssas quruluşların alınması və ilk dəfə olaraq həmin kristallara və fəthəssas quruluşlara müxtəlif növ ionlaşdırıcı şüaların (^{60}Co - qamma kvantı, enerjisi $E > 0,01$ MeV olan sürətli neytronlar, enerjisi 6 və 25 MeV olan elektron və protonlar seli) təsiri öyrənilmiş, foto həssaslığın mexanizmi müəyyən edilmişdir.

$A^{III}B^{VI}$ və $A^{III}B^{III}C^{VI}_2$ kristalları əsasında ultrabənövşəyi, görünən və yaxın infraqırmızı oblastda işləyən və müəlliflik şəhadətnamələri ilə təsbit olunmuş radiasiyaya davamlı fəthəssas quruluşlar (fotoqəbuledicilər, həssas fotodiodlar və s.) hazırlanmış və onların fiziki xassələri öyrənilmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Yarımkeçiricilər fizikası: layvari yarımkeçiricilərin elektrik, fotoelektrik və lüminessensiya xassələri, müxtəlif növ ionlaşdırıcı şüaların onlara təsiri.

Yarımkeçirici cihazlar: fəthəssas quruluşlar, fotodiodlar, metal-yarımkeçirici kontaktları, p-i-n quruluşları.

Radiasiya fizikası.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTRAKI

2006 Mater.of the fourth Eurasian Conf., Nuclear Science and application, Baku, Azerbaijan.

2004 XYIII. Mejdun. nauç-texn.konf. po Fotoelektronike i priboram noçnoqo videniya, , Moskva,

2002 The European Material Research Society Conf. E-MRS-2002 Spring Meeting, Strasbourg, France.

2018 Gəncə Dövlət Universiteti. Beynəlxalq Konfrans, 04-05 may.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Mustafayeva S.N., Kerimova E.M., İsmailzadə L.A., **Abasova A.Z.**, Kərimova R.N, İnstitute of Physics, NASA, Baku, X-ray sensivity coefficients of $\text{TlGa}_{1-x}\text{Co}_x\text{S}_2$ single crystals. Trudi. Mejdun.confer. Nayçno-texniçesk.proqress i sovremennaya aviasiya,2009,Baku
2. Kyazym-zade A.G., Salmanov V.M., **Abasova A.Z.**, Gasanova L.G, Dadashova V.V. Features of electrical properties of A^3B^6 -type layered crystals. TPE-06 3 rd Intern. conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Ankara, Turkey, 2006
3. Mustafaeva S. N., **Abasova A.Z.**, Kerimova E. M.,

Akhmedova G. M. An electric and dielectric properties of $\text{Tl}(\text{GaS}_2)_{1-x}(\text{InSe}_2)_x$ solid solutions. //

Труды пятой межд. научно-технической конференции Актуальные проблемы Физики 25-27 июня 2008 г. Баку. Азербайджан с. 290-292

4. **Абасова А. З.**, Керимова Э.М., Гасанов Н. З., Абдинбеков С. С. Фотоэлектрические свойства твердых растворов $TlGa_{1-x}In_xSe_2$. // Тр. XX Междун.научно-технич. конф.по фотоэлектронике и приборам ночного видения 27-30 мая, Москва, Россия. 2008г. с. 239-240
5. **Абасова А. З.**, Керимова Э.М., Абдинбеков С. С. Рентгеночувствительность монокристаллов GaS_xSe_{1-x} ($0 \leq x \leq 1$). // Тезисы 8-ой Межд. Конф. “Ядерная и радиационная физика” (ICNRP’11). Алматы, Казахстан. 20-23 сентября 2011 г. с.165
6. **Абасова А.З.**, Мадатов Р. С., Тадиев Т. В., Казанфаров М. Р. Влияние γ -квантов на электрические и фотоэлектрические свойства гетеропереходов в $TlInSe_2-TlSe(Ge)$. // Журн. Прикладная физика, №10, 2011 г, с. 60-65
7. **A.Z.Abasova**, L.H.Həsənova, Ə.Z.Məhəmmədov.. GaSe-Cu₃In₅S₉ heteroqecidinin fotoelektrik xassəsinə elektron şüalanmasının təsiri. SDU, Energetikanın müasir elmi-texniki və tətbiqi problemləri, 27-28 oktyabr 2015, səh.213-214
8. **Abasova A.Z.**, L.H.Həsənova, Ə.Z.Məhəmmədov. Cu₃In₅S₉ monokristalına şüalanmanın təsiri. Gəncə Dövlət Universiteti. Beynəlxalq Konfrans, 04-05 may 2018 səh.05- 06

KİTABLAR

- 1.**Abasova A. Z.**, Tağıyev İ.Q., “İfrat yüksək tezlikli elektron və kvant cihazları” ATU nəşr. Bakı 1997
2. **Абасова А.З.**, Мадатов Р. С., Стафеев В. И. Радиационно-стимулированные процессы в халькогенидных структурах. // Книга, Баку-“ЭЛМ”-2011 г, 349 с.
3. А.Н.Kazımradə, V.M.Salmanov **A.Z.Abasova**, M.Ə.Cəfərov, Ə.H.Hüseynov, L.H.,Həsənova, R.M.Məmmədov, S.Ə.Cahangirova, Ə.Z.Məhəmmədov Yarımkeçiricilər üzrə Praktikum dərş vəsəiti, Bakı “Müəllimi” nəşriyyatı, 2013,404 səh.
4. **A.Z.Abasova**, L.H.Həsənova. Yarımkeçirici materialların və cihazların parametrlərinin təyini.dərş vəsəiti 2016

CURRICULUM VITAE INFORMATION FORM

Abasova Adila Ziyat k.

Doctor of physical and mathematical sciences,
Professor of semiconductors physics department of Baku State University,
Chief of the Social Legislation Department of the Azerbaijan Parliament
The office phone: + (994) 12 439 05 15
Email: adilaabasova@yahoo.com



PERSONAL DATA

Was born 3 august 1942 year in Zangilan region of the Azerbaijan Republic.
In 1959 has left secondary school № 7 of Baku with a medal.
Married. Has 1 son.

EDUCATION AND ACADEMIC DEGREES OBTAINED

Have a Higher Education. In 1964 graduated the Physical Faculty of Azerbaijan State University.

In 1970 has protected the candidate dissertation on a theme “ Investigation of the recombination process in the Ga Se single crystals” and has received a scientific degree of the candidate of physical and mathematical sciences on a speciality 01.04.10- physics of semiconductors and dielectrics.

In 1987 has protected the dissertation on a theme “ Radiation effects in the monocrystals of semiconductors type of $A^{III}B^{VI}$, $A^{III}B^{III}C^{VI}_2$ and in their photo sensitive structures” and has received a scientific degree of the doctor of physical and mathematical sciences on a speciality 01.04.10- physics of semiconductor and dielectrics.

1995- till now professor.

2004 – Academic of the Azerbaijan sector of the International Academy of Sciences

COMPLETE PROFESSIONAL BACKGROUND

1964-1966 Institute of Physics of Azerbaijan Academy of Sciences, research assistant, engineer

1966-1969 post-graduate of the Institute of Physics of Azerbaijan Academy of Sciences

1970-1974 Institute of Physics of Azerbaijan Academy of Sciences, scientific worker, head scientific worker

1974-1992 Applied Physics Scientific Research Institute, Moscow, head scientific worker, chief of the laboratory

1992 Parliament of the Republic of Azerbaijan, chief of sector

1993 Parliament of the Republic of Azerbaijan, chief of the department of the Standing commissions

1995- till now Parliament of the Republic of Azerbaijan, chief of the Social legislation department

2004 State counselor of 2- Grade

1992-till now Professor of Semiconductors Physics Department of Baku State University

Teaching subjects: physics of semiconductors, photoelectronics, physics of irregular systems, research of the parameters of the semiconductors materials and structures.

Author of 130 scientific works

Number of the prepared candidates of sciences-3, doctors of sciences- 1

Scientific novelties: research of the influence of the ionization of the radiation (Co-60 gamma quantum , neutron with energy $E > 0,01$ MeV, electron with energy 6 and 25 MeV and proton) on the monocrystals type of $A^{III}B^{VI}$ and $A^{III}B^{III}C^{VI}_2$

For the fields of ultra-violet, visible and close infrared on the basis of the monocrystals type of $A^{III}B^{VI}$ and $A^{III}B^{III}C^{VI}_2$ solid radiation and photosensitive structures have been prepared and their physical properties have been researched.

Premium:

2007 Honors medal for Civil Service

1999 “Woman of the year” by the International Biographical Centre, England, included in encyclopedia “Outstanding people of the 20th century”

PRESENT RESEARCH INTERSETS:

Physics of semiconductors: electric and photoelectric, luminescent properties of the layered semiconductors in different ionizationed radiation

Semiconductor devices: photosensitive structures, photodiodes, metal- semiconductor contacts, p-i-n structures.

Physics of radiationю.

INTERNATIONAL CONFERENCES, SYMPOSIUMS

2006 Mater.of the fourth Eurasian Conf., Nuclear Science and application, Baku, Azerbaijan.

2004 XYIII. Mejd.nauc̣-texn.konf. po Fotoelektronike i priboram noĉnoĉo videniya, , Moskva,

2002 The European Material Research Society Conf. E-MRS-2002 Spring Meeting, Strasbourg, France.

2018 Gəncə Dövlət Universiteti. Beynəlxalq Konfrans, 04-05 may.

LIST OF SELECTED PUBLICATIONS

7. Mustafayeva S.N., Kerimova E.M., İsmailzadəh L.A., Abasova A.Z., Kərimova R.N, İnstitute of Physics, NASA, Baku, X-ray sensivity coefficients of $TiGa_{1-x}Co_xS_2$ single kristals. Trudi. Mejdun.confer. Nayĉno-texniĉesk.proqress i sovremennaya aviasiya,2009,Baku
8. Kyazym-zade A.G., Salmanov V.M., Abasova A.Z., Gasanova L.G, Dadashova V.V. Features of electrical properties of A^3B^6 -type layered crystals. TPE-06 3 rd Intern. conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Ankara, Turkey, 2006
3. Mustafaeva S. N., Абасова А.З., Керимова Е. М., Akhmedova G. M. An electric and dielectric properties of $Tl(GaS_2)_{1-x}(InSe_2)_x$ solid solutions. // Труды пятой межд. научно-технической конференции Актуальные проблемы Физики 25-27 июня 2008 г. Баку. Азербайджан с. 290-292
4. Абасова А. З., Керимова Э.М., Гасанов Н. З., Абдинбеков С. С. Фотоэлектрические свойства твердых растворов $TiGa_{1-x}In_xSe_2$. // Тр. XX Междун.научно-технич. конф.по фотоэлектронике и приборам ночного видения 27-30 мая, Москва, Россия. 2008г. с. 239-240
5. Абасова А. З., Керимова Э.М., Абдинбеков С. С. Рентгеночувствительность монокристаллов GaS_xSe_{1-x} ($0 \leq x \leq 1$). // Тезисы 8-ой Межд. Конф. “Ядерная и радиационная физика” (ICNRP’11). Алматы, Казахстан. 20-23 сентября 2011 г. с.165

6. Абасова А. З., Мадатов Р. С., Тадиев Т. В., Казанфаров М. Р. Влияние γ -квантов на электрические и фотоэлектрические свойства гетеропереходов в $\text{TlInSe}_2\text{-TlSe(Ge)}$. // Журн. Прикладная физика, №10, 2011 г, с. 60-65
7. **A.Z.Abasova**, L.H.Həsənova, Ə.Z.Məhəmmədov.. $\text{GaSe-Cu}_3\text{In}_5\text{S}_9$ heteroqəçidinin fotoelektrik xassəsinə elektron şüalanmasının təsiri. SDU, Energetikanın müasir elmi-texniki və tətbiqi problemləri, 27-28 oktyabr 2015, səh.213-214
- 8, **Abasova A.Z.**, L.H.Həsənova, Ə.Z.Məhəmmədov. $\text{Cu}_3\text{In}_5\text{S}_9$ monokristalına şüalanmanın təsiri. Gəncə Dövlət Universiteti. Beynəlxalq Konfrans, 04-05 may 2018 səh.05- 06

BOOKS

- 1.**Abasova A. Z.**, Tağıyev İ.Q., “İfrat yüksək tezlikli elektron və kvant cihazları” ATU nəşr. Bakı 1997
2. **Абасова А.З.**, Мадатов Р. С., Стафеев В. И. Радиационно-стимулированные процессы в халькогенидных структурах. // Книга, Баку-“Элм”-2011 г, 349 с.
3. A.H.Kazımradə,V.M.Salmanov **A.Z.Abasova**, M.Ə.Cəfərov, Ə.H.Hüseynov, L.H.,Həsənova, R.M.Məmmədov, S.Ə.Cahangirova, Ə.Z.Məhəmmədov Yarımqəçiricilər üzrə Praktikum dərsləri vəsaiti, Bakı “Müəllimi” nəşriyyatı, 2013,404 səh.
4. **A.Z.Abasova**, L.H.Həsənova. Yarımqəçirici materialların və cihazların parametrlərinin təyini.dərs vəsaiti 2016

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ФОРМА

Абасова Адиля Зият кызы

Доктор физико-математических наук,
Профессор кафедры физики полупроводников БГУ,
Зав. отделом Социального законодательства Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики
Рабочий телефон +(994)12 439-05 -15
e-mail: adilaabasova@yahoo.com



КОРОТКО О СЕБЕ

Родилась 3 августа 1942 года в Зангеланском районе Азербайджанской Республики
В 1959 г. окончила среднюю школу N 7 г.Баку с медалью.
Замужняя, имеет 1 сына

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ

Образование высшее. В 1964 г. окончила физический факультет Азербайджанского Государственного Университета.

В 1970 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Исследование радиационных процессов в слоистых монокристаллах типа GaSe» и получила ученую степень кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10-физика полупроводников и диэлектриков.

В 1987г. защитила докторскую диссертацию на тему: «Радиационные эффекты в слоистых полупроводниках типа $A^{III}B^{VI}$, $A^{III}B^{III}C^{VI}_2$ и фоточувствительных структурах на их основе» и получила ученую степень доктора физико-математических наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников и диэлектриков.

Является профессором с 1995 г.

Является действительным членом Азербайджанского Сектора Международной Академии Наук с 2004 г.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1964-1966 Институт Физики Академии Наук Азербайджанской Республики,
старший лаборант, инженер

1966-1970 Института Физики Академии Наук Азербайджанской Республики,
аспирант

1970-1974 Институт Физики Академии Наук Азербайджанской Республики,
младший научный сотрудник, старший научный сотрудник

1974 откомандирована в Научно-Исследовательский Институт Прикладной Физики (г. Москве)

1983-1992 Научно-Исследовательский Институт Прикладной Физики (г. Москва)
старший научный сотрудник, заведующий лабораторией

1992 Верховный Совет Азербайджанской Республики зав. сектором

1993-1995 Милли Меджлис Азербайджанской Республики, зав. отделом Постоянных Комиссии

С 1995 г. по настоящее время – зав. отделом Социального законодательства Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

2004 присвоено звание Государственного Советника 2 –го класса

С 1992-го по настоящее время профессор кафедры «Физика полупроводников» Бакинского Государственного Университета.

Преподает предметы: Физика полупроводников, фотоэлектроника, физика неупорядоченных систем, определение параметров полупроводников и приборов.

Является автором 130 научных работ

Число подготовленных кандидатов наук - 3, докторов наук - 1

Научные новизны: Впервые исследовано влияние различных видов ионизирующих излучений (^{60}Co гамма-кванты, электроны с энергией 6 МэВ и 25 МэВ, нейтроны с энергией $E > 0,1$ МэВ, протоны) на слоистые полупроводники типа $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{VI}}$ и $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{III}}\text{C}_2^{\text{VI}}$ и фоточувствительные структуры на их основе. Обнаружено что, малые дозы облучений не влияют на их характеристики. Установлен механизм фоточувствительности в слоистых полупроводниках, облученных различными видами излучений.

Премии:

В 2007 г. Награждена медалью «за отличие на Государственной службе»

В 1999г. Международным Центром Биографии Великобритании объявлена «Женщиной года», включена в энциклопедическую книгу «Выдающиеся лица XX-века», издаваемую этим Центром, и удостоена дипломом и медалью.

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Физика полупроводников: Электрические, фотоэлектрические и люминесцентные свойства слоистых полупроводников и влияние на них ионизирующих излучений.

Полупроводниковые приборы: фоточувствительные структуры, фотодиоды, контакты металл-полупроводник.

Радиационная физика.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ И СЕМИНАРАХ

2006, Mater. Jf the fourth Eurasian Conf., Nuclear Science and application, Baku, Azerbaijan

2004, XVIII Межд. научн. – техн. Конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, Москва

2002 The European Material Research Society Conf. E-MRS Spring Meeting, Strasbourg, France

2018 Gəncə Dövlət Universiteti. Beynəlxalq Konfrans, 04-05 may.

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ:

1. Mustafayeva S.N., Kerimova E.M., İsmailzadəh L.A., Abasova A.Z., Kərimova R.N, İnstitute of Physics, NASA, Baku, X-ray sensivity coefficients of $\text{TlGa}_{1-x}\text{Co}_x\text{S}_2$ single kristals. Trudı. Mejdun.confer. Nayçno-texniçesk.proqress i sovremennaya aviasiya,2009,Baku

2. Kyzym-zade A.G., Salmanov V.M., Abasova A.Z., Gasanova L.G, Dadashova V.V. Features of electrical properties of A^3B^6 -type layered crystals. TPE-06 3rd Intern. conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Ankara, Turkey, 2006
3. Mustafaeva S. N., Абасова А.З., Керимова Е. М., Akhmedova G. M. An electric and dielectric properties of $Tl(GaSe)_{1-x}(InSe)_x$ solid solutions. // Труды пятой межд. научно-технической конференции Актуальные проблемы Физики 25-27 июня 2008 г. Баку. Азербайджан с. 290-292
4. Абасова А. З., Керимова Э.М., Гасанов Н. З., Абдинбеков С. С. Фотоэлектрические свойства твердых растворов $TlGa_{1-x}In_xSe_2$. // Тр. XX Междун.научно-технич. конф.по фотоэлектронике и приборам ночного видения 27-30 мая, Москва, Россия. 2008г. с. 239-240
5. Абасова А. З., Керимова Э.М., Абдинбеков С. С. Рентгеночувствительность монокристаллов GaS_xSe_{1-x} ($0 \leq x \leq 1$). // Тезисы 8-ой Межд. Конф. “Ядерная и радиационная физика” (ICNRP'11). Алматы, Казахстан. 20-23 сентября 2011 г. с.165
6. Абасова А. З., Мадатов Р. С., Тадиев Т. В., Казанфаров М. Р. Влияние γ -квантов на электрические и фотоэлектрические свойства гетеропереходов в $TlInSe_2$ - $TlSe(Ge)$. // Журн. Прикладная физика, №10, 2011 г, с. 60-65
7. **A.Z.Abasova**, L.H.Həsənova, Ə.Z.Məhəmmədov.. $GaSe-Cu_3In_5S_9$ heteroqəçidinin fotoelektrik xassəsinə elektron şüalanmasının təsiri. SDU, Energetikanın müasir elmi-texniki və tətbiqi problemləri, 27-28 oktyabr 2015, səh.213-214
8. **Abasova A.Z.**, L.H.Həsənova, Ə.Z.Məhəmmədov. $Cu_3In_5S_9$ monokristalına şüalanmanın təsiri. Gəncə Dövlət Universiteti. Beynəlxalq Konfrans, 04-05 may 2018 səh.05- 06

КНИГИ

- 1.**Abasova A. Z.**, Tağıyev İ.Q., “İfrat yüksək tezlikli elektron və kvant cihazları” ATU nəşr. Bakı 1997
2. **Абасова А.З.**, Мадатов Р. С., Стафеев В. И. Радиационно-стимулированные процессы в халькогенидных структурах. // Книга, Баку-“Элм”-2011 г, 349 с.
3. A.H.Kazımrzadə,V.M.Salmanov **A.Z.Abasova**, M.Ə.Cəfərov, Ə.H.Hüseynov, L.H.,Həsənova, R.M.Məmmədov, S.Ə.Cahangirova, Ə.Z.Məhəmmədov Yarımkeçiricilər üzrə Praktikum dərsləri vəsaiti, Bakı “Müəllimi” nəşriyyatı, 2013,404 səh.
4. **A.Z.Abasova**, L.H.Həsənova. Yarımkeçirici materialların və cihazların parametrlərinin təyini.dərs vəsaiti 2016